

	<h2 style="color: red;">FCP190N65S3R0</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FCP190N65S3R0
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 190MOHM TO220 I
Datenblätter:	 FCP190N65S3R0.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		



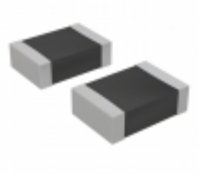


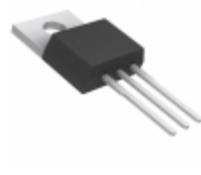
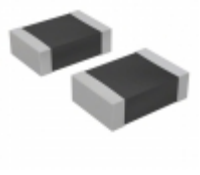

Spezifikationen

Teilenummer	FCP190N65S3R0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 190MOHM TO220 I
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.7mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	144W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 17A (Tc) 144W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

FCP190N65S3R0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP190N65S3R0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP190N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP190N65S3R0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP190N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 17A TO220-3</p>	 <p>FCP190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p>FCP1913H104G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP190N65F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>
 <p>FCP1913H104G-E3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor FCP190N60_GF102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCP1913H104G-E2 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 2% 50VDC 1913</p>	 <p>FCP190N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP190N65S3R0 AMI Semiconductor / FCP190N65S3R0 Datenblatt	FCP190N65S3R0-Datenblätter	FCP190N65S3R0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP190N65S3R0
FCP190N65S3R0 Electronic	FCP190N65S3R0-Komponenten	FCP190N65S3R0-Verteiler	FCP190N65S3R0-Bild
FCP190N65S3R0 Preis	FCP190N65S3R0 Hersteller	FCP190N65S3R0 Bild	FCP190N65S3R0 Aktie
FCP190N65S3R0 Neu	FCP190N65S3R0 Original	FCP190N65S3R0 garantiert	FCP190N65S3R0 RFQ
			FCP190N65S3R0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited